

PHASE CONTROL THYRISTORS

Stud Version

Features

- High current and high surge ratings
- $dv/dt = 1000V/\mu s$ option
- Ceramic housing
- Threaded studs UNF 1/2 - 20UNF2A
- Types up to 1200V V_{RRM}/V_{DRM}
- $di/dt = 300A/\mu s$

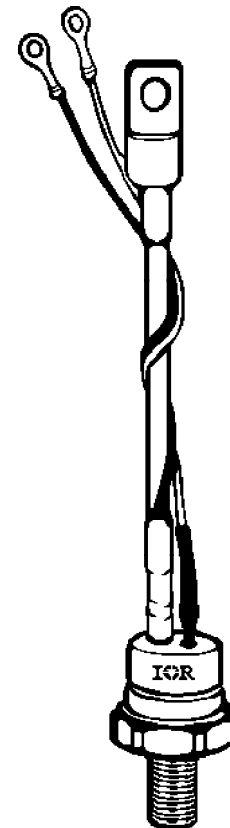
110A

Typical Applications

- DC motor controls
- Controlled DC power supplies
- AC controllers

Major Ratings and Characteristics

Parameters	111RKI	Units
$I_{T(AV)}$	110	A
@ T_C	90	°C
$I_{T(RMS)}$	172	A
I_{TSM} @ 50Hz	2080	A
@ 60Hz	2180	A
I^2t @ 50Hz	21.7	KA ² s
@ 60Hz	19.8	KA ² s
V_{DRM}/V_{RRM}	400 to 1200	V
t_q typical	110	μs
T_J	- 40 to 140	°C



case style
TO-209AC (TO-94)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS**Voltage Ratings**

Type number	Voltage Code	$V_{\text{DRM}}/V_{\text{RRM}}$, max. repetitive peak and off-state voltage V	V_{RSM} , maximum non-repetitive peak voltage V	$I_{\text{DRM}}/I_{\text{RRM}}$ max. @ $T_J = T_J$ max. mA
111RKI	40	400	500	20
	80	800	900	
	120	1200	1300	

On-state Conduction

Parameter	111RKI	Units	Conditions
$I_{\text{T(AV)}}$ Max. average on-state current @ Case temperature	110	A	180° conduction, half sine wave
	90	°C	
$I_{\text{T(RMS)}}$ Max. RMS on-state current	172	A	DC @ 83°C case temperature
I_{TSM} Max. peak, one-cycle non-repetitive surge current	2080		t = 10ms No voltage
	2180		t = 8.3ms reapplied
	1750		t = 10ms 100% V_{RRM}
	1830		t = 8.3ms reapplied
I^2t Maximum I^2t for fusing	21.7	KA^2s	t = 10ms No voltage
	19.8		t = 8.3ms reapplied
	15.3		t = 10ms 100% V_{RRM}
	14.0		t = 8.3ms reapplied
$I^2\sqrt{t}$ Maximum $I^2\sqrt{t}$ for fusing	217	$\text{KA}^2\sqrt{\text{s}}$	t = 0.1 to 10ms, no voltage reapplied
$V_{\text{T(TO)1}}$ Low level value of threshold voltage	0.82	V	$(16.7\% \times \pi \times I_{\text{T(AV)}} < I < \pi \times I_{\text{T(AV)}}), T_J = T_J$ max.
$V_{\text{T(TO)2}}$ High level value of threshold voltage	1.02		$(I > \pi \times I_{\text{T(AV)}}), T_J = T_J$ max.
r_{t1} Low level value of on-state slope resistance	2.16	mΩ	$(16.7\% \times \pi \times I_{\text{T(AV)}} < I < \pi \times I_{\text{T(AV)}}), T_J = T_J$ max.
r_{t2} High level value of on-state slope resistance	1.70		$(I > \pi \times I_{\text{T(AV)}}), T_J = T_J$ max.
V_{TM} Max. on-state voltage	1.57	V	$I_{\text{pk}} = 350\text{A}, T_J = T_J$ max., $t_p = 10\text{ms}$ sine pulse
I_{H} Maximum holding current	150	mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$, anode supply 6V resistive load
I_{L} Typical latching current	400		

Switching

Parameter	111RKI	Units	Conditions
di/dt Max. non-repetitive rate of rise of turned-on current	300	A/μs	Gate drive 20V, 20Ω, $t_r \leq 1\mu\text{s}$ $T_J = T_J$ max, anode voltage $\leq 80\% V_{\text{DRM}}$
t_d Typical delay time	1	μs	Gate current 1A, $di_g/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ $V_d = 0.67\% V_{\text{DRM}}, T_J = 25^\circ\text{C}$
t_q Typical turn-off time	110		$I_{\text{TM}} = 50\text{A}, T_J = T_J$ max., $di/dt = -5\text{A}/\mu\text{s}, V_R = 50\text{V}$ $dv/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}$, Gate 0V 25Ω

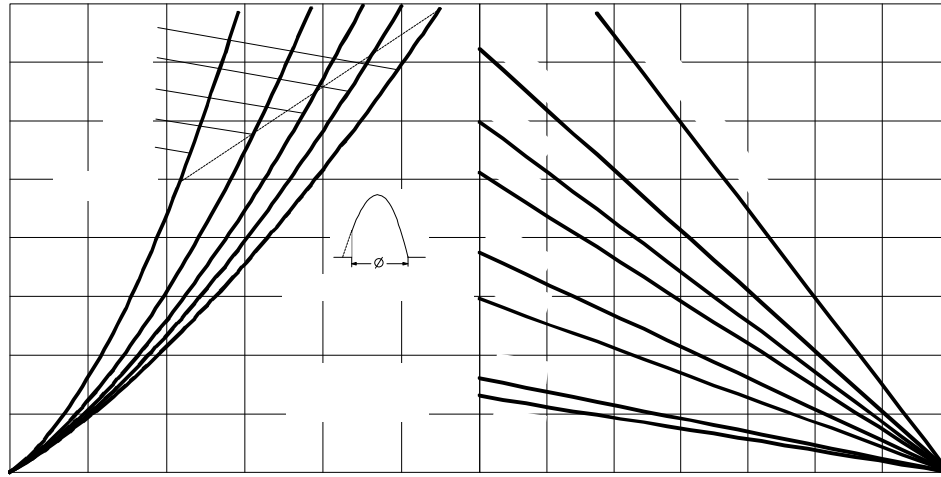


Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics

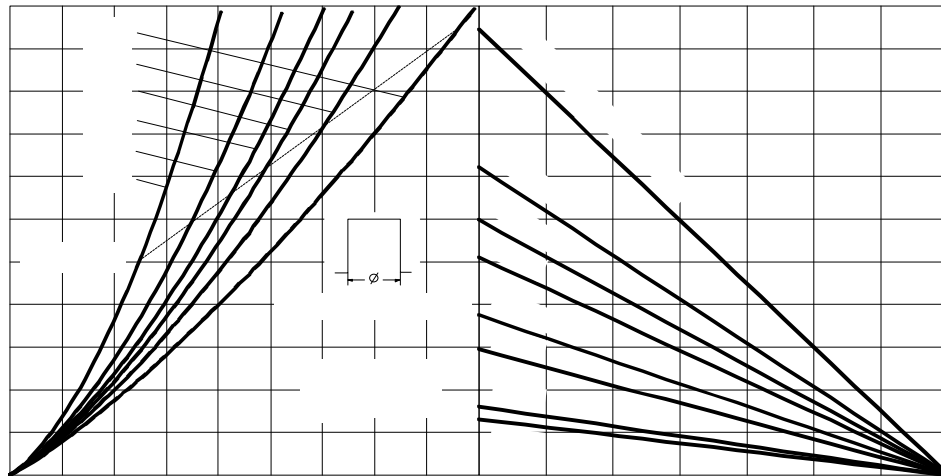


Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics

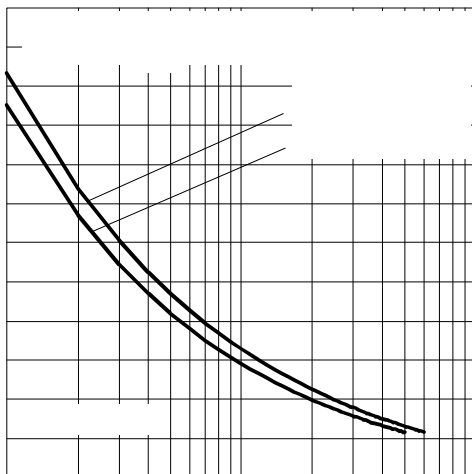


Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

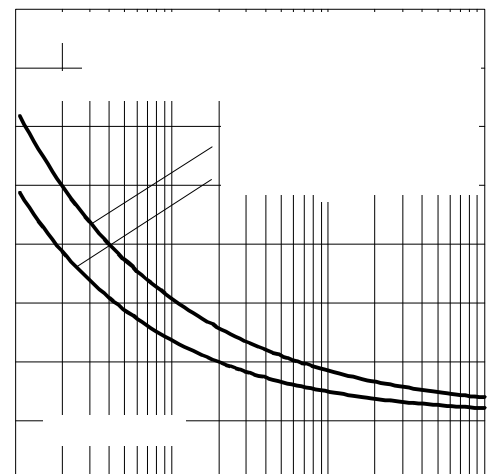


Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

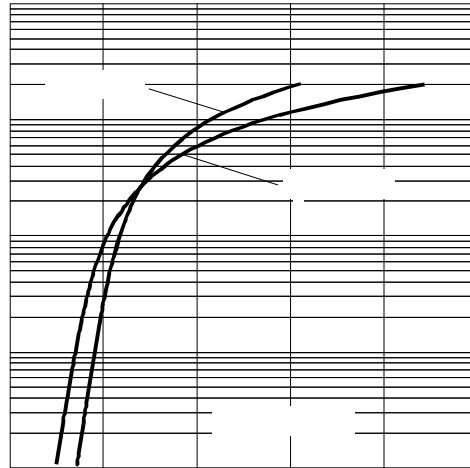


Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics

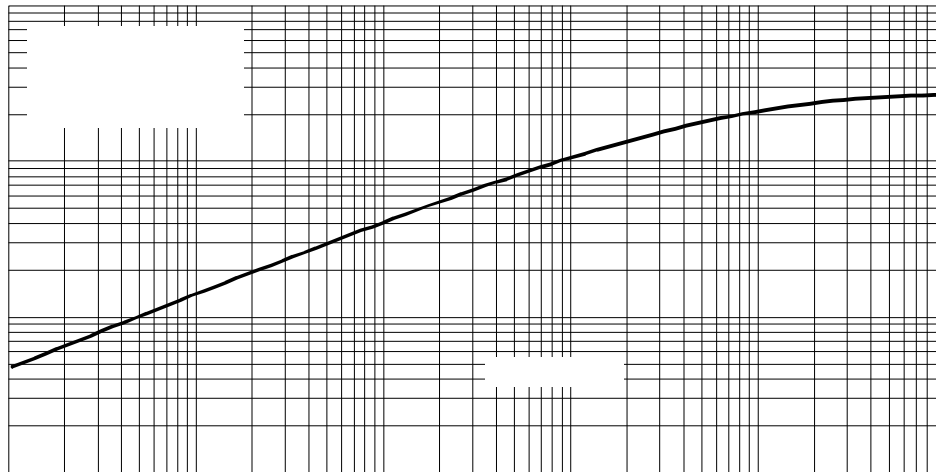


Fig. 8 - Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristic

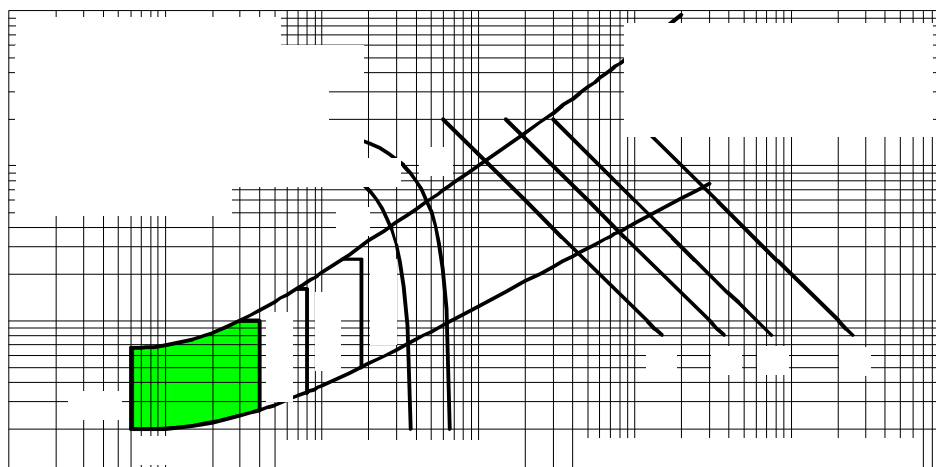


Fig. 9 - Gate Characteristics

Blocking

Parameter	111RKI	Units	Conditions
dv/dt Maximum critical rate of rise of off-state voltage	500	V/ μ s	$T_J = T_J$ max. linear to 80% rated V_{DRM}
I_{RRM} I_{DRM} Max. peak reverse and off-state leakage current	20	mA	$T_J = T_J$ max, rated V_{DRM}/V_{RRM} applied

Triggering

Parameter	111RKI	Units	Conditions
P_{GM} Maximum peak gate power	12	W	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$P_{G(AV)}$ Maximum average gate power	3.0		$T_J = T_J$ max, $f = 50$ Hz, $d\% = 50$
I_{GM} Max. peak positive gate current	3.0	A	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$+V_{GM}$ Maximum peak positive gate voltage	20	V	$T_J = T_J$ max, $t_p \leq 5$ ms
$-V_{GM}$ Maximum peak negative gate voltage	10		
I_{GT} DC gate current required to trigger	TYP.	MAX.	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$ Max. required gate trigger/ current/ voltage are the lowest value which will trigger all units 12V anode-to-cathode applied
	180	-	
	80	100	
V_{GT} DC gate voltage required to trigger	40	-	$T_J = -40^\circ\text{C}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 140^\circ\text{C}$
	2.5	-	
	1.6	2	
I_{GD} DC gate current not to trigger	6.0	mA	$T_J = T_J$ max Max. gate current/ voltage not to trigger is the max. value which will not trigger any unit with rated V_{DRM} anode-to-cathode applied
V_{GD} DC gate voltage not to trigger	0.25	V	

Thermal and Mechanical Specification

Parameter	111RKI	Units	Conditions
T_J Max. operating temperature range	-40 to 140	$^\circ\text{C}$	
T_{stg} Max. storage temperature range	-40 to 150		
R_{thJC} Max. thermal resistance, junction to case	0.27	K/W	DC operation
R_{thCS} Max. thermal resistance, case to heatsink	0.1		Mounting surface, smooth, flat and greased
T Mounting torque, $\pm 10\%$	15.5	Nm (lbf-in)	Non lubricated threads
	(137)		
	14		Lubricated threads
	(120)		
wt Approximate weight	130	g	
Case style	TO - 209AC (TO-94)		See Outline Table

Case Style TO-208AD (TO-83)
All dimensions in millimeters (inches)

Outline Table

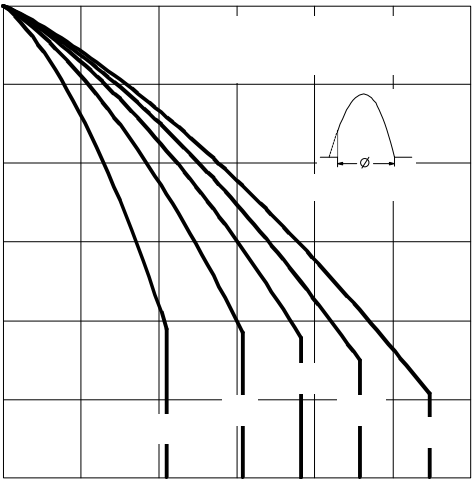
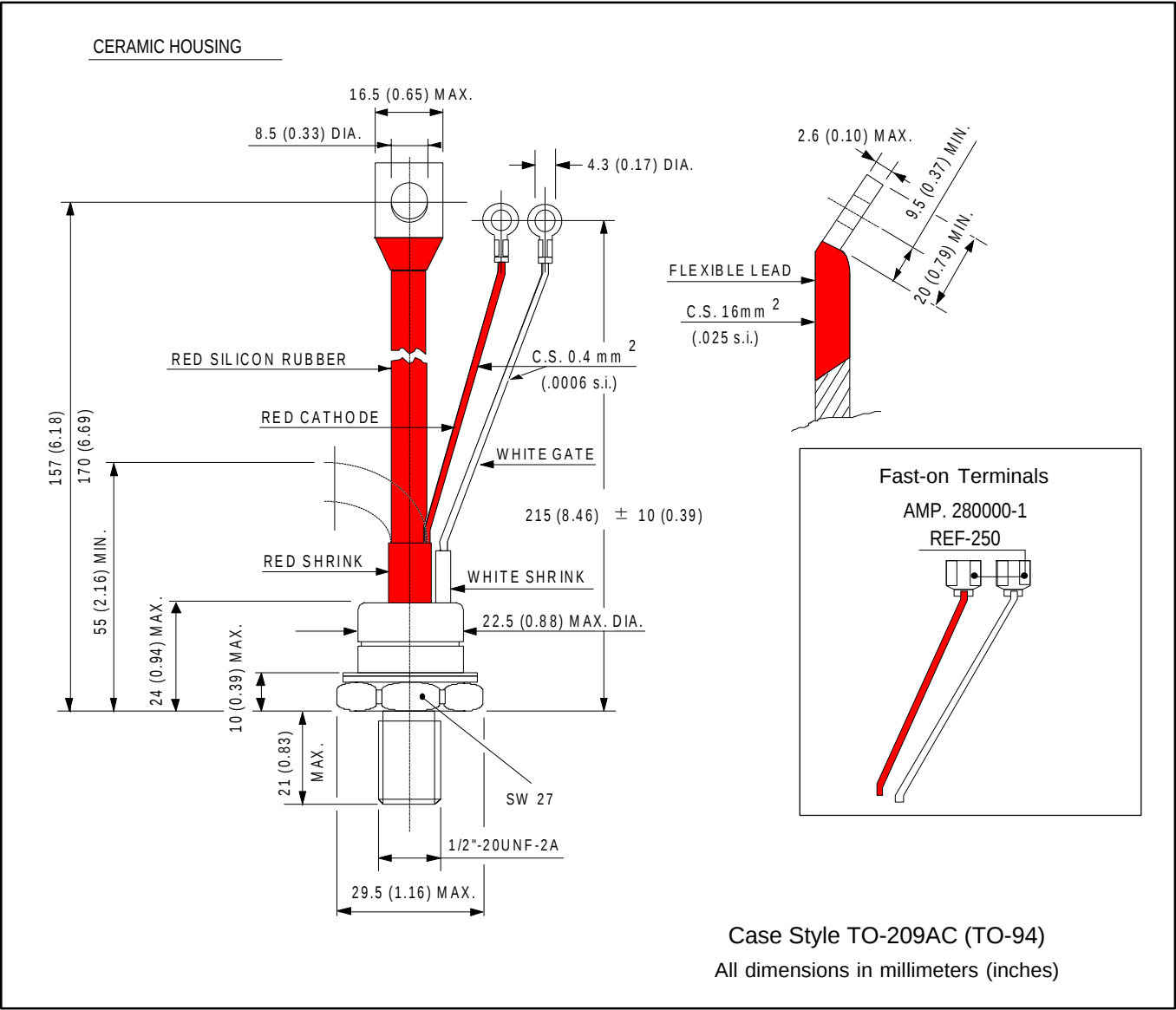


Fig. 1 - Current Ratings Characteristics

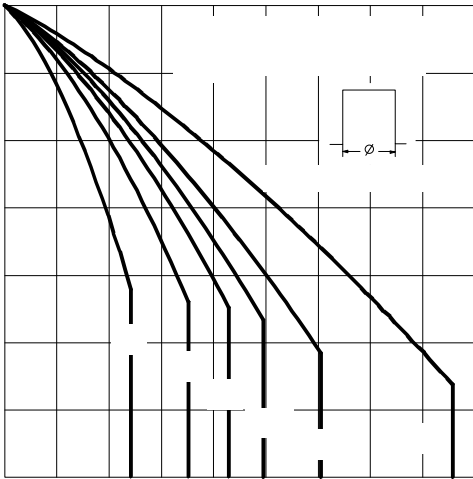


Fig. 2 - Current Ratings Characteristics



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331